

Сведения об официальном оппоненте
 по диссертационной работе (Лошаченко Антон Сергеевич)
 на тему «Взаимодействие водорода с дислокационными сетками сращенных пластин кремния»

представленной на соискание ученой степени
 кандидата физико-математических наук
 по специальности 01.04.10 – физика полупроводников

Фамилия Имя Отчество оппонента	Зубков Василий Иванович
Шифр и наименование специальности, по которым защищена диссертация	01.04.10– физика полупроводников
Ученая степень и отрасль науки	Доктор физико-математических наук
Ученое звание	Доцент
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
Занимаемая должность, с указанием структурного подразделения	профессор кафедры Микро- и нанoeлектроники (МНЭ), факультет электроники (ФЭЛ)
Почтовый индекс, адрес	197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5
Телефон	8(812)234-31-64
Адрес электронной почты	vzubkovspb@mail.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dorokhin M.V., Zaitsev S.V., Rykov A.V., Zdoroveyshchev A.V., Malysheva E.I., Danilov Y.A., Zubkov V.I., Frolov D.S., Yakovlev G.E., Kudrin A.V. Heterostructures with InGaAs/GaAs quantum dots doped with transition elements: II. Study of the circularly polarized luminescence (2017) Technical Physics, 62 (10), pp. 1545-1550. 2. Shestakova L., Yakovlev G., Zubkov V. Electrochemical capacitance-voltage measurements and modeling of GaAs nanostructures with delta-doped layers (2017) Journal of Physics: Conference Series, 816 (1), статья № 012022. 3. Zubkov V.I., Solomnikova A.V., Post J.E., Gaillou E., Butler J.E. Characterization of electronic properties of natural type IIb diamonds (2017) Diamond and Related Materials, 72, pp. 87-93. 4. Frolov D.S., Zubkov V.I. Automated instrumentation for nonequilibrium capacitance-voltage measurements at a semiconductor-electrolyte interface (2017) Instruments and Experimental Techniques, 60 (1), pp. 119-121. 5. Yakovlev G., Frolov D., Zubkova A., Zubkov V. ECV investigation of ion-implanted photosensitive silicon structures for backside illuminated CCDs (2016) Journal of Physics: Conference Series, 769 (1), статья № 012058.

6. Frolov D.S., Zubkov V.I. Frequency dispersion of capacitance-voltage characteristics in wide bandgap semiconductor-electrolyte junctions (2016) *Semiconductor Science and Technology*, 31 (12), статья № 125013.
7. Yakovlev G., Frolov D., Zubkova A., Zubkov V. ECV investigation of ion-implanted photosensitive silicon structures for backside illuminated CCDs (2016) *Journal of Physics: Conference Series*, 769 (1), статья № 012058.
8. Yakovlev G., Frolov D., Zubkov V. Investigation of delta-doped pHEMT InGaAs/GaAs/AlGaAs structures by the electrochemical capacitance-voltage technique (2016) *Journal of Physics: Conference Series*, 690 (1), статья № 012015.
9. Frolov D., Yakovlev G., Zubkov V. Measurements of doping density in InAs by capacitance-voltage techniques with electrolyte barriers (2015) *Journal of Physics: Conference Series*, 643 (1), статья № 012086.
10. Zubkov V.I., Kucherova O.V., Bogdanov S.A., Zubkova A.V., Butler J.E., Ilyin V.A., Afanas'ev A.V., Vikharev A.L. Temperature admittance spectroscopy of boron doped chemical vapor deposition diamond (2015) *Journal of Applied Physics*, 118 (14), статья № 145703.
11. Zubkov V.I., Kucherova O.V., Yakovlev I.N., Solomonov A.V. An automated system based on cryogenic probe station for integrated studies of semiconductor light-emitting structures and wafers in the range of 15 to 475 K (2015) *Russian Microelectronics*, 44 (3), pp. 203-209.
12. Zubkov V., Kucherova O., Frolov D., Zubkova A. Electrochemical profiling of heterostructures with multiple quantum wells InGaN/GaN (2013) *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics*, 10 (3), pp. 342-345.

Верно

Начальник отдела
диссертационных советов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Т.Л. Русяева



« _____ » _____ 2018 г.

М.П.